Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0593U000027

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-02-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Романюк Борис Николаевич

2. Романюк Борис Николаевич

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd_type_names.0

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 25-12-1992

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Институт физики полупроводников НАН Украины

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: 252022,Киев-22, пр. Науки, 45

Форма власності:

Сфера управління: НАН Украины

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 016.25.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Институт полупроводников АН Украины

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: 252650, Киев-28, пр.Науки, 45

Форма власності:

Сфера управління: НАН Украины

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:

1. Процессы ионно-стимулированного массопереноса и гетерирования в полупроводниковых планарных структурах

2.

Реферат/анотація:

1. Объект исследования: Полупроводниковые кристаллы кремния и слоистые структуры диэлектрик-полупроводник. Цель исследования: Разработка научных основ ионно-стимулированного формирования слоистых структур и изучение процессов переноса и взаимодействия точечных дефектов с атомами примесей в кремнии. Методы исследования и аппаратура: Просвечивающая и растровая электронная микроскопия, рентгеновская спектроскопия, комбинационное рассеивание и электроотражение света, резерфордовское рассеивание альфа-частиц; электронные микроскопы, установки для имплантации, оптические приборы, Оже-спектрометр. Теоретические результаты и новизна: Установление механизмов ионно-стимулированного упорядочивания; кристаллические решетки; изучение механизмоа стимулированного гетерирования; выявление эффектов лазерно-стимулированной диффузии кислорода и каталитической роли угля. Практические результаты и новизна: Разработана и внедрена в производство технология гетерирования при эпитаксионном росте пленок. Предложены методы создания скрытых

диэлектрических слоев и p-n переходов при низких температурах. Получено 10 авторских свидетельств на изобретение. Предмет и степень внедрения: Технология гетерирования примесей в эпитаксиальных пленках внедрена на ВО "Гама" г.Запорожье. Эффективность внедрения: Экономический эффект от внедрения результатов 3 млн.крб. Сфера (область) использования: Микроэлектроника, технология полупроводниковых материалов.

2.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Птушинский Ю.Г.

2. Птушинский Ю.Г.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.04, 1

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Баранский П.И.

2. Баранский П.И.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10, 1

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мордкович В.Н.

2. Мордкович В.Н.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10, 1

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Свечников С.В.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Свечников С.В.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.